

## 真空コンポーネント

・MeiVac社製品

Makマグネトロンスパッタリングソース

画期的な水冷システムを採用

ターゲット交換がワンタッチで容易

マグネットは強磁性材料

動作圧力が広く高真空から低真空まで作動

電源はDC/RF対応

電流回路がシールドされているので反射ロスも少ない

写真は2インチスパッタソース



ターゲットサイズ

1.3"から6"各種取扱い

真空シールは高真空対応及びOリング

既存の真空チャンバーへ取付が容易



スパッタリングターゲット

各種取扱がございます。

お問い合わせください。

### Relative Rates

Cu=1.0

Ag	2.06
Al	0.73
Al2O3	0.15
Au	1.76
Be	0.22
Bi	10.00
C	0.05
CdS(1010)	2.39
CdTe	0.64
Co	0.58
Cr	0.60
Cu	1.00
Dy	1.18
Er	1.00
Fe	0.56
GaAs(110)	1.70
Gd	1.17
Ge	1.05
Glass	0.23
Hf	0.67
Ir	0.61
Mg	0.26
MgF	0.03
Mn	0.99
Mo	0.53
Nb	0.44
Ni	0.65
Os	0.5
Pb	3.52
Pd	1.31
Pt	0.9
Rb	4.55
Re	0.53
Rh	0.74
Ru	0.66
Sb	3.68
Si	0.39
SiC	0.36
SiO	0.27
SiO2	0.45
Sm	1.14
Sn	1.38
Ta	0.43
Th	0.84
Ti	0.38
U	0.73
V	0.38
W	0.39
Y	0.95
Zr	0.65

### RELATIVE RATES

Under identical power and geometric conditions target materials will sputter at different rates. The attached table provides relative rates for 50 common elements and compounds where Copper = 1.00.

## 基板加熱 ヒータ

酸素雰囲気中で950℃まで 使用可能

様々な反応ガスにも対応

均一性に優れたヒータ表面温度

写真は2インチ基板加熱ヒータ



Part Number	SU-200-HH	SU-200-IH	SU-300-HH	SU-400-IH	SU-600-IH
Stage Type	Sample	Wafer	Sample	Wafer	Wafer
Size (inches)	2	2	3	4	6
Dimension (inches)	<i>Refer to sketches</i>				
A	2.50	3.00	3.50	5.00	6.75
B	3.33	3.48	3.83	5.60	7.38
C	2.37	2.37	2.37	3.30	3.30
D	2.12	2.62	2.62	3.00	3.00
E	1.38	1.38	1.38	2.30	2.30
Max. Temperature	950C	950C	950C	950C	950C
Temp. Uniformity	+/-1%	+/-1%	+/-1%	+/-2%	+/-2%
Area of uniformity	center 1.25" dia.	2" dia.	center 2.25" dia.	4" dia.	6" dia.
Temp. Repeatability	12 C	12 C	12 C	13 C	13 C
Ramp time to 950C	12 min	12 min	13 min	22 min	30 min
Cool-down time	35 min	35 min	40 min	3 hrs	4 hrs
Max. Current	10 A	10 A	9 A	14 A	14 A
Max. Voltage	45 V	45 V	85 V	85 V	135 V
Input power	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC
Heater resistance	5 ohms	5 ohms	10 ohms	6 ohms	10 ohms
Heater material	Haynes	Inconel	Haynes	Inconel	Inconel

基板取付治具用 タップ 穴追加加工 できます。（ご注文時にご指示願います。）